

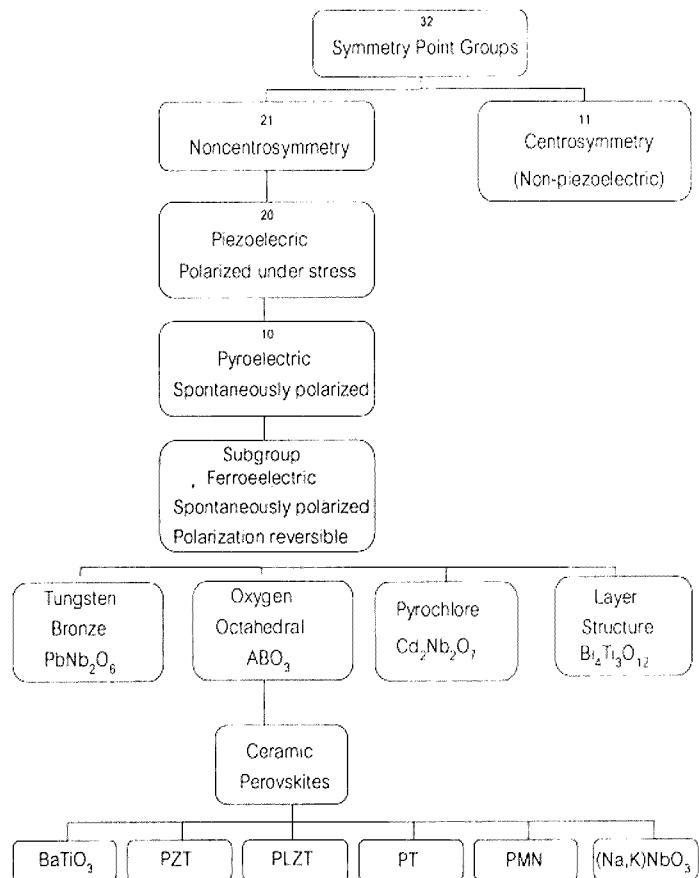
บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการเตรียมผงและเซรามิกแบบเรียบเซอร์โคเนตไททาเนตด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง (solid state reaction) และวิธีการเผาไหม้ (combustion) ด้วยเงื่อนไขการเตรียมและปริมาณเซอร์โคเนียมต่าง ๆ กัน นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างจุลภาค โครงสร้างเฟส และสมบัติทางกายภาพของเซรามิกแบบเรียบเซอร์โคเนตไททาเนต ซึ่งก็จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้งาน ในบทนี้จึงกล่าวถึงโครงสร้างของเซรามิกแบบเรียบเซอร์โคเนตไททาเนต ซึ่งเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริก (ferroelectric) กลุ่มที่มีโครงสร้างแบบเพอร์โอดส์ไกท์ (perovskite) ตลอดจนขั้นตอน วิธีการเตรียม และการตรวจสอบโครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของผงผลึกและเซรามิกแบบเรียบเซอร์โคเนตไททาเนต

เฟอร์โรอิเล็กทริก

ปรากฏการณ์เฟอร์โรอิเล็กทริกถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1921 [1] ซึ่งวัสดุประเภทเฟอร์โรอิเล็กทริกนี้จะแสดงสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก เช่น เกิดโพลาไรเซชันได้เอง (spontaneous polarization) เกิด เฟอร์โรอิเล็กทริกโดเมน (ferroelectric domains) และเฟอร์โรอิเล็กทริกไฮสเตอร์езิสลูป (ferroelectric hysteresis loop) ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดคูรี (Curie point) มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกอย่างมากมายในปี ค.ศ. 1950 [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเรียบไททาเนต (barium titanate, BT) ซึ่งเป็นวัสดุพื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก และทرانสดิวเซอร์ (transducer) นอกจากนี้ยังมีเซรามิกชนิดเฟอร์โรอิเล็กทริกอื่น ๆ อีกเช่น เลดไททาเนต (lead titanate, PT) เลดเซอร์โคเนตไททาเนต (lead zirconate titanate, PZT) และเลดแลนثانัมเซอร์โคเนตไททาเนต (lead lanthanum zirconate titanate, PLZT) การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกทำให้มีการประยุกต์ใช้งานด้านใหม่ ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วเซรามิกประเภทเฟอร์โรอิเล็กทริกมักจะนำมาประยุกต์สำหรับตัวเก็บประจุไฟฟ้า



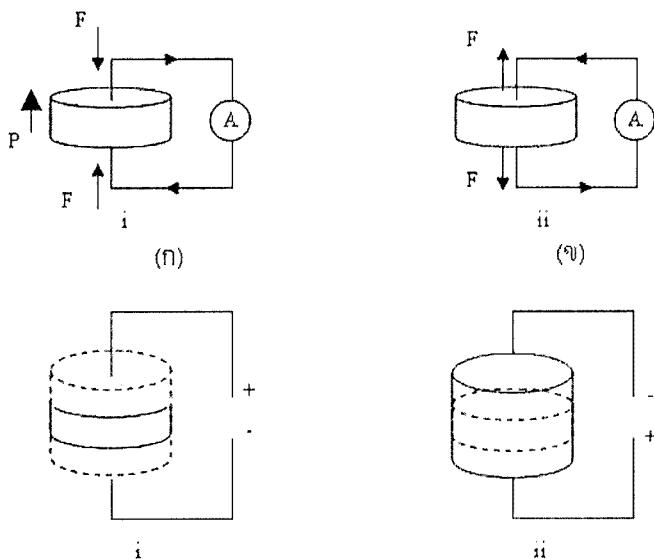
ภาพ 1 การแบ่งกลุ่มเฟอร์โรอิเล็กทริกตามลักษณะสมมาตร [1]

นักผลิตศาสตร์แบ่งผลึกออกเป็น 32 กลุ่ม ดังภาพ 1 จากผลึก 32 กลุ่ม มี 21 กลุ่มที่ไม่มีสมมาตรของศูนย์กลาง (noncentrosymmetric) ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เฟอร์โรอิเล็กทริก ซึ่งพบถึง 20 กลุ่ม เนื่องจากแรงกดที่ให้กับวัสดุเป็นแบบที่มีสมมาตรของศูนย์กลาง นอกจาว่าวัสดุนั้นมีลักษณะไม่สมมาตรของศูนย์กลางอยู่เบื้องหลัง จึงจะทำให้ผลรวมของการเคลื่อนที่ของประจุบวกและลบสามารถสร้างได้โดยไฟฟ้าขึ้นมา หรือที่เรียกว่าโพลาไรเซชัน (polarization) สภาพเพียงเฟอร์โรอิเล็กทริกเกิดได้สองแบบคือ ผลทางตรง (direct effect) และผลย้อนกลับ (converse effect) แสดงดังภาพ 2 ผลทางตรงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดประจุไฟฟ้าจากการให้แรงทางกล ส่วนผลย้อนกลับ การทำงานทางกลจะเกิดจากการให้สนาณไฟฟ้าเข้าไป [1] ดังสมการ

$$P_i = d_{ijk} \sigma_{jk} \quad (2.1)$$

$$\epsilon_{ij} = d_{kij} E_k \quad (2.2)$$

- เมื่อ P_i คือ โพลาไรเซชัน
 σ_{jk} คือ ความเดัน
 ϵ_{ij} คือ ความเครียด
 d_{kij} ค่าสัมประสิทธิ์เพียงโซอิเล็กทริก
 E_k คือ สนามไฟฟ้า

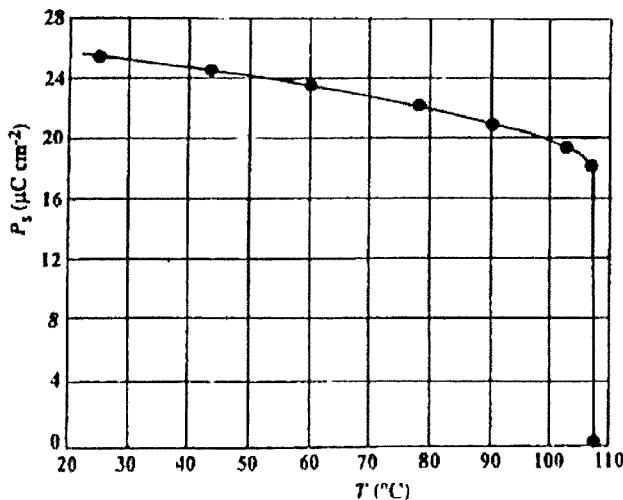


ภาพ 2 ปรากฏการณ์เพียงโซอิเล็กทริกในวัสดุ (ก) แบบตรง (ข) แบบผันกลับ [8]

จาก 21 กลุ่มผลึกที่แสดงสมบัติเพียงโซอิเล็กทริก มีเพียง 10 กลุ่มที่มีสภาพมีข้อถกเถียงในโครงสร้างและสามารถเกิดโพลาไรเซชันได้ด้วยตัวเอง (spontaneous polarization, P_s) การเกิดโพลาไรเซชันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอุณหภูมิ ดังภาพ 3 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับอุณหภูมนี้เรียกว่า ปรากฏการณ์ไฟโรอิเล็กทริก (pyroelectric effect) สามารถอธิบายในเทอมของสัมประสิทธิ์ไฟโรอิเล็กทริก (pyroelectric coefficient, π) ดังสมการ

$$\Delta P_s = \pi \Delta T \quad (2.3)$$

- เมื่อ ΔP_s คือ การเปลี่ยนแปลงโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเอง
 ΔT การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงสั้นๆ



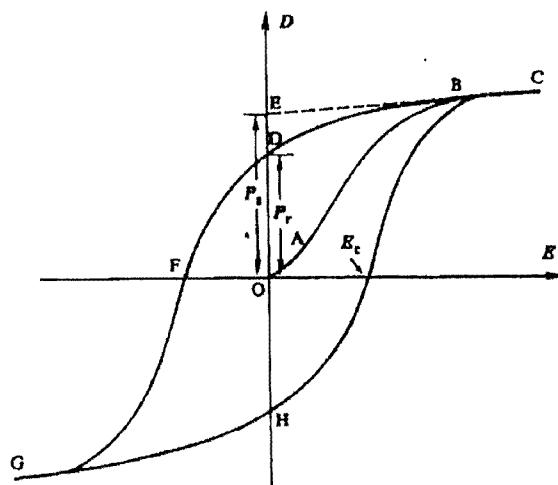
ภาพ 3 ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีต่อโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเอง (P_s) ของแม่เรียมไทดานเนต (BaTiO_3) [2]

จากภาพ 3 พบร่วมกับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเองจะค่อยๆ ลดลง ค่าสัมประสิทธิ์ ไฟโรอิเล็กทริกจึงมีค่าเป็นลบ และที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดครูวิค่าโพลาไรเซชันจะเป็นศูนย์ทันที

ถ้าขนาดและทิศทางของโพลาไรเซชันสามารถกลับได้ด้วยสนามไฟฟ้าจากภายนอกแล้ว จะเรียกผลึกที่แสดงสมบัติตั้งกล่าวว่าเป็นเฟรโรอิเล็กทริก ดังนั้นผลึกที่แสดงพฤติกรรมเป็นเฟรโรอิเล็กทริกจะเป็นไฟโรอิเล็กทริกด้วย แต่ผลึกที่เป็นไฟโรอิเล็กทริกอาจจะไม่มีสมบัติเป็นเฟรโรอิเล็กทริก

ผลึกเฟรโรอิเล็กทริกที่มีโพลาไรเซชันในทิศทางเดียวกัน จะเรียกว่าเป็นเฟรโรอิเล็กทริกโดเมน (ferroelectric domain) ภายในหนึ่งโดเมนขึ้นไปฟ้าหักหมดจะมีทิศทางเดียวกัน และหลาย ๆ โดเมนในผลึกจะถูกแบ่งแยกด้วยผิวร่วมที่เรียกว่า ผนังโดเมน (domain wall) ในแต่ละผลึกของเฟรโรอิเล็กทริกจะมีเฟรโรอิเล็กทริกโดเมนอยู่มากมาย ซึ่งสามารถทำให้ผลึกที่ประกอบไปด้วยหลาย ๆ โดเมนมีโพลาไรเซชันในทิศทางเดียวกัน หรือเป็นโดเมนเดียวได้ด้วยสนามไฟฟ้าจากภายนอก โดยสนามไฟฟ้าจะไปกลับทิศของโพลาไรเซชันให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน

ความแตกต่างระหว่างวัสดุที่เป็นไฟโรอิเล็กทริกและเฟรโรอิเล็กทริกคือ ทิศทางของโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเอง ในวัสดุประเภทไฟโรอิเล็กทริก โพลาไรเซชันสามารถกลับทิศได้ด้วยสนามไฟฟ้าจากภายนอก และการกลับทิศทางของโพลาไรเซชันนี้สามารถอธิบายได้ด้วยเฟรโรอิเล็กทริกอีสเทอร์รีซิส (ferroelectric hysteresis) แสดงดังภาพ 4



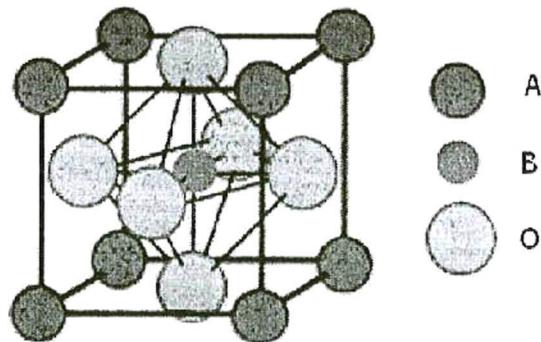
ภาพ 4 เฟรโรอิเล็กทริกอีสเทอร์รีซิส [2]

เมื่อเริ่มให้สนามไฟฟ้าการเกิดโพลาไรเซชันจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามเส้นทาง OB จนกระทั่งถึงจุดอิมตัว ที่จุด B ซึ่งโพลาไรเซชันมีค่ามากที่สุด (saturation polarization, P_{sat}) หากเพิ่มสนามไฟฟ้าไปมากกว่านี้จะไม่มีผลต่อการเกิดโพลาไรเซชัน และเมื่อสนามไฟฟ้ามีค่าลดลงโพลาไรเซชันจะไม่ย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิม แม้ว่าจะไม่มีการให้สนามไฟฟ้าก็ตามแต่ยังคงมีโพลาไรเซชันเหลืออยู่ (remanent polarization : P_r) ที่จุด D และโพลาไรเซชันจะลดลงสู่ศูนย์ที่จุด F เมื่อให้สนามไฟฟ้าในทิศทางลบ (OF) และเรียกสนามไฟฟ้านี้ว่า สนามโคเออร์ซีฟ (Coercive field, E_C) ถ้าเราพยายามให้สนามไฟฟ้าในทิศทางลบนี้สูงขึ้นอีก โพลาไรเซชันจะอิมตัวที่จุด G จากนั้นโพลาไรเซชันจะเพิ่มขึ้นทางขวาไปยังจุด H และเมื่อให้สนามไฟฟ้าอีกครั้ง ในทิศทางบวก โพลาไรเซชันจะกลับสู่ศูนย์และครบลูปที่จุดอิมตัว B ซึ่งตำแหน่งที่เส้นสัมผัสสอง (CE) ตัดกันโพลาไรเซชันก็คือค่า โพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเอง P_s ของเฟรโรอิเล็กทริก [2]

เฟร์โรอิเล็กทริกกลุ่มที่มีโครงสร้างแบบเพอร์อพสไกต์

เชรามิกชนิดเฟร์โรอิเล็กทริกแบ่งตามโครงสร้างของหน่วยเซลล์ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังภาพ 1 กลุ่มที่มีความสำคัญที่สุด คือกลุ่มที่มีโครงสร้างเป็นแบบเพอร์อพสไกต์ (perovskite; ABO_3) [1] โครงสร้างของหน่วยเซลล์ ABO_3 สามารถอธิบายด้วยโครงสร้างคิวบิกอย่างง่าย โดยทั่วไปธาตุ A ได้แก่ $\text{Pb}, \text{Ca}, \text{Ba}, \text{Sr}, \text{Na}, \text{K}$ จะเป็นแคตไอออน (cation) ที่มีขนาดใหญ่ ใหญ่ที่สุดและอยู่ที่มุมทั้ง 8 ของรูปทรงลูกบาศก์ (cubic) ส่วนธาตุ B อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของรูปทรงออกตะเขิดรอล (octahedral) เป็นแคตไอออนที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กที่สุด ได้แก่ $\text{Ti}, \text{Zr}, \text{Nb}, \text{Ta}, \text{W}$ ฯลฯ และสุดท้ายคือแอนไฮเดรต (anions) ซึ่งได้แก่ออกซิเจนทั้ง 6 ตัว จะอยู่ที่กึ่งกลางผิวน้ำ (face center) ทั้ง 6 ด้าน ของรูปทรงคิวบิก [8,9]

แบบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนต เป็นสารที่มีโครงสร้างเพอร์อพสไกต์ มี Ba^{2+} เป็นแคตไอออนขนาดใหญ่อยู่ที่มุมทั้ง 8 ของรูปทรงคิวบิก ส่วนที่กึ่งกลางของออกตะเขิดรอล มี Ti^{4+} หรือ Zr^{4+} เป็นแคตไฮเดรต แอนไฮเดรต และถูกล้อมด้วยออกซิเจนซึ่งเป็นแอนไฮเดรต อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางทั้ง 6 หน้าของออกตะเขิดรอล ดังภาพ 5

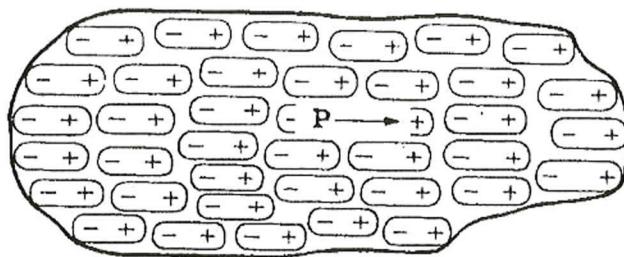


ภาพ 5 หน่วยเซลล์ของ ABO_3 [1]

หากเฟร์โรอิเล็กทริกได้รับอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิคูรีของสารนั้นแล้ว สารดังกล่าวจะกลایสภาพเป็นพาราอิเล็กทริก โดยผลก็มีความสมมาตรกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ ผลที่ตามมาคือ จะไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันด้วยตนเองได้ และเมื่อลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่าอุณหภูมิคูรี สารดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนสภาพจากพาราอิเล็กทริกไปเป็นเฟร์โรอิเล็กทริก เช่นเดิม ทำให้ศูนย์กลางมีการเปลี่ยนตำแหน่ง และโครงสร้างผลึกแบบคิวบิกจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างผลึกที่ไม่มีความสมมาตรกับศูนย์กลาง ตัวอย่างโครงสร้างดังกล่าว เช่น เทtrapagonal (tetragonal) รวมไปยัง rhombohedral หรือ monoclinic

ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก

สารไดอิเล็กทริก คือ อนวนที่มีสภาพยอมสัมพัทธ์สูง เนื่องจากสารหั้งหมด ประกอบขึ้นด้วยโมเลกุล โดยที่โมเลกุลเหล่านี้ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่มีประจุไฟฟ้า เมื่อเราให้สนามไฟฟ้าแก่ตัวกลาง สนามไฟฟ้าจะทำให้มีแรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุ สำหรับประจุบวกจะได้รับแรงในทิศทางเดียวกับสนาม ส่วนประจุลบนั้นจะถูกแรงกระทำในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นส่วนที่เป็นบวกและเป็นลบของแต่ละโมเลกุลจะย้ายจากตำแหน่งสมดุลไปในทิศทางตรงกันข้ามเกิดเป็นไดโอล (dipole) ดังภาพ 6 ไดอิเล็กทริกที่ถูกทำให้มีข้าวลักษณะเช่นนี้เราระบุว่า พลาไรเซชัน (polarization, \vec{P})



ภาพ 6 สารที่มีข้าวไฟฟ้าของไดอิเล็กทริก [2]

พลาไรเซชันที่เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสนามไฟฟ้าจากภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่จะขึ้นอยู่กับสมบัติของโมเลกุลที่ประกอบขึ้นเป็นไดอิเล็กทริกด้วย พลาไรเซชันจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้าและมีทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้า และสามารถเขียนได้ด้วยสมการ

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad (2.4)$$

เมื่อ χ_e คือ สารรับได้ทางไฟฟ้า (electric susceptibility) ของตัวกลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางจุลภาคของตัวกลาง ϵ_0 คือ สภาพยอมของสูญญากาศ (permittivity of a vacuum) มีค่าคงที่ $8.854 \times 10^{-12} F/m$

สนามไฟฟ้าในสมการ (2.4) เป็นสนามไฟฟ้าหั้งหมด ที่เกิดจากประจุอิสระและจากพลาไรเซชัน ดังนั้นปริมาณการกระจัดทางไฟฟ้า (electric displacement, \vec{D}) จึงเขียนได้เป็น

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (2.5)$$

เมื่อรวมสมการ (2.4) เข้ากับ (2.5) จะได้

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \\ &= \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} \end{aligned} \quad (2.6)$$

และ

$$\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \quad (2.7)$$

เมื่อ ϵ คือ สภาพยอม (permittivity) ของวัสดุ

ดังนั้นสมการ (2.6) จึงเขียนใหม่ได้เป็น

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (2.8)$$

จากสมการ (2.8) จะพบว่าโพลาไรเซชันและการกระจัดไฟฟ้าจะขึ้นกับสนามไฟฟ้า

เนื่องจากในสัญญาการไม่มีสารที่ก่อให้เกิดโพลาไรเซชัน ดังนั้นสภาพรับได้ทางไฟฟ้า จึงเป็นศูนย์ นั่นคือ ค่าสภาพยอม (ϵ) จึงมีค่าเท่ากับสภาพยอมของสัญญาการ (ϵ_0) และจาก สมการ (2.7) จะได้

$$\frac{\epsilon}{\epsilon_0} = (1 + \chi_e) = \epsilon_r$$

หรือ

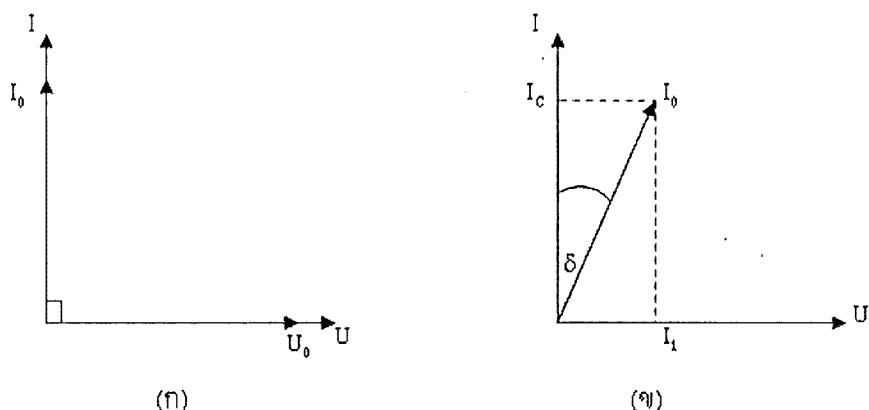
$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (2.9)$$

เมื่อ ϵ_r คือ สภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) หรือ ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก (dielectric constant) [10]

เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสงลับให้กับวัสดุไดอิเล็กทริก สนามไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดจะทำ ให้เกิดไดโอลภายในวัสดุไดอิเล็กทริก และในการนี้อุดมคติไดโอลภายในวัสดุไดอิเล็กทริก สามารถสับทิศทางได้ตามความถี่ของแหล่งกำเนิด ซึ่งกรณีนี้กระแสงลับ (/) และศักย์ไฟฟ้า (U) มีความต่างเพียง 90 องศา ดังภาพ 7 (ก) ทำให้ผลคูณสเกลาร์ (scalar product) ของ กระแสไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียพลังงานของวัสดุไดอิเล็กทริก (dielectric loss, $\tan\delta$) เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงการสับทิศทางของไดโอลจะก่อให้เกิด

ความต้านทาน ภายในเนื้อวัสดุเอง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานขึ้น ซึ่งกรณีนี้จะเรียกว่าไฟฟ้า กับศักย์ไฟฟ้ามีความต่างเพสกันน้อยกว่า 90 องศา ดังภาพ 6 (ข) โดยค่าการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นนั้น สามารถตรวจได้จากการทดลองและเป็นอัตราส่วนของสภาพยอมจินตภาพ (imaginary permittivity, ϵ') และสภาพยอมจริง (real permittivity, ϵ'') ดังสมการ

$$\tan \delta = \frac{\epsilon'}{\epsilon''} \quad (2.10)$$



ภาพ 7 ความต่างเพสระหว่างกระแสลับ (I) และศักย์ไฟฟ้า (U) ของวัสดุไดอิเล็กทริก
 (ก) กรณีไม่มีการสูญเสียพลังงาน (ข) กรณีมีการสูญเสียพลังงาน [18]

ค่าทันตะบิลิตี้

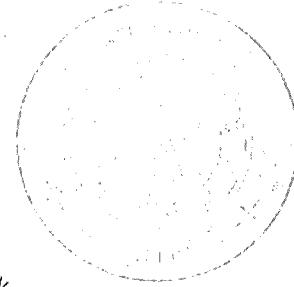
การใช้งานไดอิเล็กทริกภายใต้สนามไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสมบัติของวัสดุ โดยจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่าคงตัวไดอิเล็กทริก ทันตะบิลิตี้ (tunability, k) ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบค่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์กับค่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่สนามไฟฟ้าที่นำไปประยุกต์ใช้งาน โดยค่าทันตะบิลิตี้สามารถคำนวณได้ดังสมการ

$$k = \frac{\epsilon(0) - \epsilon(E)}{\epsilon(0)} \quad (2.11)$$

เมื่อ $\epsilon(0)$ คือ ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์

$\epsilon(E)$ คือ ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่สนามไฟฟ้าที่นำไปประยุกต์ใช้งาน

โดยทั่วไปมักจะนองค่าทันตะบิลิตี้ของวัสดุเปรียบเทียบกับค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก ที่เรียกว่า figure of merit (FOM) ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังสมการ



$$FOM = \frac{k}{\tan \delta} \quad (2.12)$$

จากสมการ 2.12 วัสดุที่มีค่าทันอะบิลิตี้สูงและมีค่าสัญเสียงต่ำจะทำให้ได้ค่า FOM ที่สูง ดังนั้นวัสดุที่มีค่า FOM สูงจึงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการผลิต tunable capacitor [4]

การบดย่อย

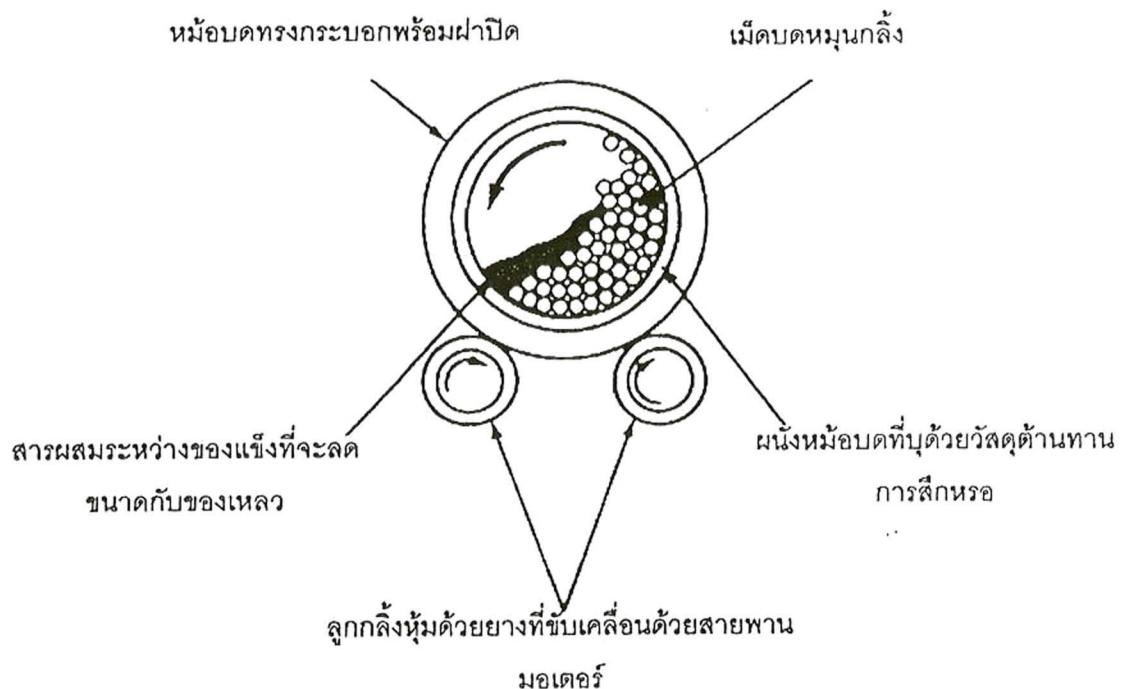
การบดย่อย (milling) เป็นหนึ่งในกระบวนการพื้นฐานที่นิยมใช้กันมากในการผลิตสารหลายชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้อุณภูมิขนาดเล็กพอที่จะนำไปใช้เตรียมเป็นชิ้นงานเชรามิกต่อไปได้ ในกระบวนการบดย่อยนั้น อุณภูมิจะได้รับความเค้นเชิงกล (mechanical stresses) เนื่องจากแรงจากการกดอัด (compression) แรงจากการกระแทก (impact) หรือแรงจากการเฉือน (shear) ณ ตำแหน่งที่อุณภูมิสัมผัสกับเม็ดบดหรือสัมผัสกับอุณภูมิอื่น เมื่อความเค้นเชิงกลมากเกินความแข็งแรงของอุณภูมิจะแตก [11,12]

เทคนิคในการบดย่อยที่ใช้กันทั่วไปในทางอุตสาหกรรมและในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การบดย่อยด้วยลูกบอล (ball milling) การบดย่อยแบบสั่นกระแทก (vibratory mill) การบดย่อยแบบลบสึก (attrition mill) และการบดย่อยด้วยพลังงานจากของเหลว (fluid energy mill)

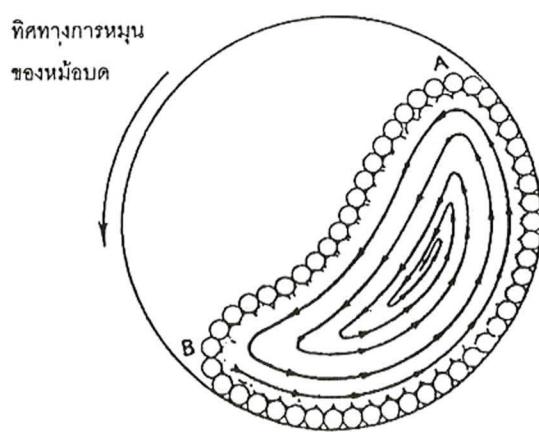
สำหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้เทคนิคการบดย่อยด้วยลูกบอล เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ไม่ยุ่งยาก และนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในห้องปฏิบัติการ

ระบบของเครื่องบดย่อยด้วยลูกบอล ประกอบด้วย หม้อบดซึ่งมักทำด้วยวัสดุที่มีความแข็ง เช่น พอร์ซเลน (porcelain) อะลูมีนา (alumina) เหล็ก (steel) หรือ ทังสเตนคาร์บิด (tungsten carbide) หรือวัสดุที่อ่อนและยืดหยุ่น เช่น ยาง หรือ polyethylene ส่วนลูกบด (media) นิยมใช้แบบทรงกลมหรือทรงกระบอก และควรทำการทำความสะอาดและทำความสะอาดตัวเองที่ของลูกบดในลักษณะเลื่อนหล่นกันไป (cascading) ดังภาพ 8 อนุภูมิของสารจะถูกบดย่อยจาก

การบดย่อยด้วยลูกบอลเป็นกระบวนการบดย่อยอุณภูมิของสารโดยอาศัยการหมุนของหม้อบดซึ่งเป็นภาชนะทรงกระบอก ที่บรรจุสารที่จะทำการลดขนาด ลูกบด และของเหลว ต่าง ๆ หม้อนบนแกนหมุนของเครื่องบดในแนวอน ดังภาพ 8 อนุภูมิของสารจะถูกบดย่อยจาก การเคลื่อนที่ของลูกบดในลักษณะเลื่อนหล่นกันไป (cascading) ดังภาพ 9



ภาพ 8 องค์ประกอบหลักของการบดย่อยด้วยลูกบด [13]



ภาพ 9 ลักษณะการบดแบบเลื่อนหลั่น (cascading) [14]

การเคลื่อนที่ของลูกบดในลักษณะนี้จะทำให้อนุภาคน้ำยาเคลื่อนที่อยู่ระหว่างลูกบด และระหว่างลูกบดกับหม้อบด ทำให้เกิดการขัดสี การกระแทก และการแตกออกเป็นอนุภาคน้ำยาที่มีขนาดเล็กลงในระหว่างที่มีการบดย่อย

ประสิทธิภาพในการบดย่อยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

1. ความเร็วและความถี่ในการชนกันของลูกบด ซึ่งจะเพิ่มขึ้นถ้าขนาดของลูกบดที่ใช้เล็กลง แต่อย่างไรก็ตามความเร็วของลูกบดจะถูกจำกัดด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
2. อัตราการชนกันของลูกบดกับผัง ต่อการประทับระหว่างลูกบด ซึ่งพบว่าในกรณีที่ลูกบดเป็นทรงกระบอก จะมีอัตราการชนกันของลูกบดกับผังต่อการประทับของระหว่างลูกบดสูงกว่ากรณีที่ลูกบดเป็นทรงกลม เนื่องจากรูปร่างแบบทรงกระบอกมีพื้นผิวที่แแบนมากกว่า จึงทำให้ยึดจับอนุภาคของสารไว้ที่ผิวของลูกบดได้ดีกว่า
3. อัตราการแตกของอนุภาค ต่อการชนกันของลูกบดกับผัง พบร่วมกับลูกบดที่มีความถ่วงจำเพาะสูง สามารถทำให้อนุภาคเกิดการลดขนาดได้เร็วกว่า [12]

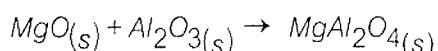
การบดย่อยด้วยลูกบดสามารถทำได้สองวิธี คือ แบบแห้ง (dry milling) และแบบเปียก (wet milling) สำหรับการบดแบบแห้งอัตราส่วนที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพดีในการบดประกอบด้วยส่วนของลูกบดประมาณร้อยละ 50 ของปริมาตรหม้อบด และเดิมอนุภาคของสารประมาณร้อยละ 25 ของปริมาตรหม้อบด ส่วนการบดแบบเปียกจะประกอบด้วยลูกบดประมาณร้อยละ 50 ของปริมาตรหม้อบด อนุภาคของสารประมาณร้อยละ 24 - 40 ของปริมาตรหม้อบด และของเหลวประมาณร้อยละ 40 ของปริมาตรหม้อบด [15]

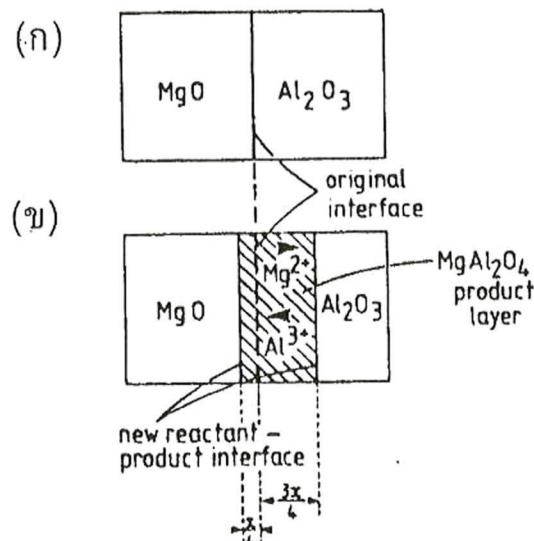
ในงานวิจัยนี้เลือกการบดแบบเปียกเนื่องจากการบดแบบเปียกมีความเร็วในการหมุนสูงกว่าช่วยในการผสมสารให้เข้ากันอย่างทั่วถึง และอนุภาคที่ได้มีขนาดเล็กกว่าแบบแห้ง

ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

ของแข็งมักจะไม่เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง การเกิดปฏิกิริยาสถานะของแข็ง (solid state reaction) จะต้องอาศัยการสลายตัวทางเคมีของตัวทำปฏิกิริยา เพื่อให้เกิดเป็นของแข็งชนิดใหม่ ด้วยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงประมาณ $1,000 - 1,500^{\circ}\text{C}$ และมีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการเกิดปฏิกิริยา ได้แก่ ปัจจัยทางเคมีไนโตรเจน แมกนีเซียม และปัจจัยทางจนพลศาสตร์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติทางเคมีของตัวทำปฏิกิริยา และทำให้สามารถนำพาอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้

พิจารณาการเกิดปฏิกิริยาสถานะของแข็งระหว่าง MgO กับ Al_2O_3 เพื่อให้ได้สารประกอบ MgAl_2O_4 แสดงดังสมการ

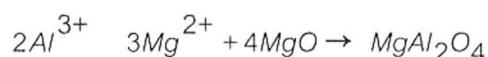




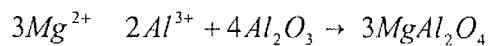
ภาพ 10 ลักษณะการเกิดปฏิกิริยาโดยการแพร่ของแคทไอโอนของผลึก MgO และ Al_2O_3 [7]

ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นตรงบริเวณหน้าสัมผัสระหว่างผลึกของ MgO และ Al_2O_3 ดังภาพ 10(ก) หลังจากให้ความร้อนแก่ผลึกของ MgO และ Al_2O_3 โดยบางส่วนจะเกิดปฏิกิริยาและฟอร์มตัวเป็นชั้นของ $MgAl_2O_4$ ตรงบริเวณรอยต่อของหน้าสัมผัสระหว่างผลึก ในขั้นตอนแรกของปฏิกิริยาการฟอร์มตัวเป็นไปได้อย่าง เนื่องจากโครงสร้างที่แตกต่างระหว่างสารตั้งต้นและสารประกอบที่ต้องการ ซึ่งมีการจัดเรียงโครงสร้างใหม่ของสารประกอบจำนวนมาก โดยจะมี การถ่ายพันธะและฟอร์มตัวชั้นมาใหม่ ไอโอน Mg^{2+} ใน MgO และ Al^{3+} ใน Al_2O_3 จะพยายามเข้าไปจับกับแล็ตทิสที่อยู่ข้างเคียง แต่เป็นการยากเนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีที่ว่าง นอกเสียจากจะมีพลังงานความร้อนที่มากพอ จนไอโอนดังกล่าวสามารถหลุดออกจากแล็ตทิส และแพร่กระจายไปทั่วทั้งผลึก และในที่สุดจะมีการฟอร์มตัวใหม่เป็น $MgAl_2O_4$ ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนของไอโอนหัวลง บริเวณรอยต่อของหน้าสัมผัสระหว่างผลึกของ MgO และ Al_2O_3 จะเกิดเป็นชั้นของ $MgAl_2O_4$ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเกิดปฏิกิริยาที่รอยต่อของหน้าสัมผัสสองคู่ คือระหว่าง MgO กับ $MgAl_2O_4$ และ $MgAl_2O_4$ กับ $MgAl_2O_4$ ดังภาพ 10 (ข) และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสามารถเขียนได้ดังสมการ

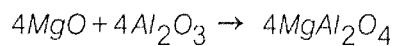
ที่หน้าสัมผัสระหว่าง MgO กับ $MgAl_2O_4$



ที่หน้าสัมผัสระหว่าง $MgAl_2O_4$ กับ $MgAl_2O_4$



ปฏิกิริยารวมที่เกิดขึ้น คือ



การแพร่ของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎอัตราพาราโบลิก (parabolic rate law) ดังสมการ

$$\frac{dx}{dt} = kx^2 \quad (2.13)$$

หรือ

$$x = \left(\frac{k}{t} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2.14)$$

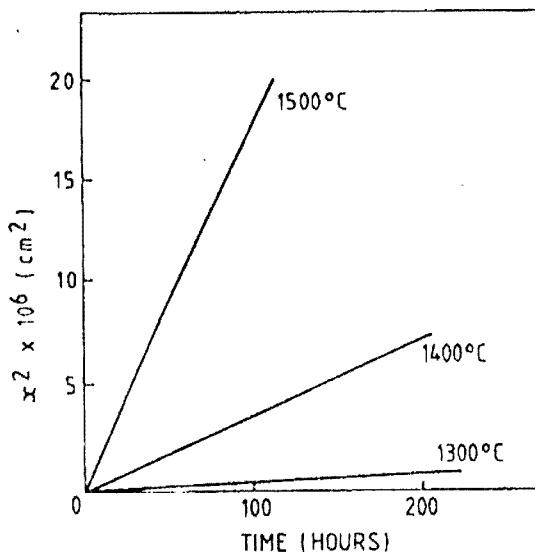
เมื่อ x คือ จำนวนของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น หรือ ความหนาของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

การทำปฏิกิริยา

t คือ ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา

k' ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งเป็นพองค์ชั้นของอุณหภูมิและเวลา

อัตราการเกิดปฏิกิริยาสามารถวัดได้จากความหนาของชั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นพองค์ชั้นของเวลา ตามความสัมพันธ์ของอาร์เรนียส (Arrhenius) แสดงดังภาพ 11 เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำปฏิกิริยายกกำลังสอง (x^2) กับช่วงเวลาในการทำปฏิกิริยา (t) ซึ่งความชันของกราฟก็คือค่าคงที่ k' และจากกราฟความสัมพันธ์ดังกล่าว พบว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว



ภาพ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของผลิตภัณฑ์ กับช่วงเวลาในการทำปฏิกิริยา [7]

อัตราการเกิดปฏิกิริยาแบบพาราโบลิก ในช่วงเริ่มต้นจะถูกควบคุมด้วยการแพร่เป็นหลัก แต่ในบางปฏิกิริยาจะค่อนข้างช้าบช้อน เนื่องจากมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ได้แก่ ธรรมชาติทางเคมีของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ ขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของขนาดอนุภาค ความสม่ำเสมอของผงผสมซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการแพร่และจำนวนจุดสัมผัสระหว่างตัวทำปฏิกิริยา บรรยายกาศ อุณหภูมิและเวลาในการเกิดปฏิกิริยา โดยที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดของตัวทำปฏิกิริยาลดลง เนื่องจากระยะทางของการแพร่ลดลง และอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามความสัมพันธ์ของอาร์กโนนิยส์

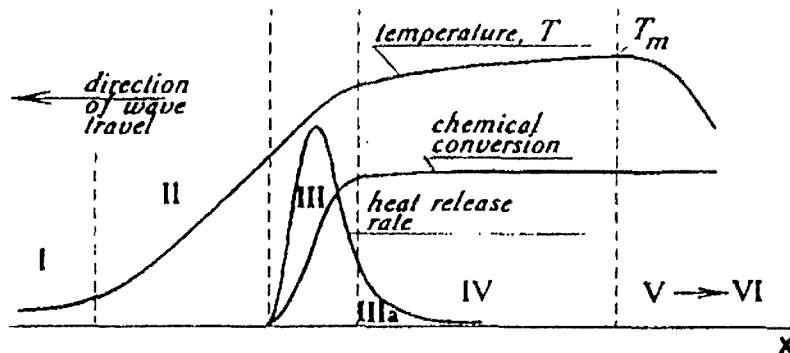
ข้อดีของการเตรียมผงด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง คือ มีค่าใช้จ่ายน้อยและสามารถเตรียมผงได้ปริมาณมาก แต่ปัญหาสำคัญ คือ การเกาะกลุ่มของอนุภาคผง จึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการบดอย่างลูกบอลมาช่วยลดขนาดของอนุภาค [18]

การเตรียมผงด้วยวิธีการเผาไหม้

การใช้ประโยชน์จากการปลดปล่อยพลังงานความร้อนที่ได้จากการปฏิกิริยาเคมี ในขั้นตอนการผลิตมีการใช้กันมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อ Beketov และ Goldshmidt ได้ค้นพบ self-sustaining thermite reaction ซึ่งต่อมาได้ใช้หลักการจุดระเบิดของปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตอย่างมากmany เช่น ในกระบวนการผลิตเตาหลอมเหล็ก การผลิตเฟอร์โรอัลลอย ฯลฯ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทฤษฎีการเผาไหม้ (combustion) ยุคใหม่ไม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เคยปฏิบัติมา (ในปี ค.ศ.1930-1940 สำหรับแก๊ส และปี ค.ศ.1950-1960

สำหรับของเหลว) ในปี ค.ศ.1967 ได้มีการค้นพบปรากฏการณ์จุดระเบิดของของแข็ง ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะได้ผลผลิตในสถานะของแข็ง และการพัฒนาวิธีการเผาไหม้บันบันเพ็นฐานของ self-propagation high-temperature (SHS) ได้กระตุ้นให้เกิดการทดลองและการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเผาไหม้ของสารประกอบอนินทรีย์และวัสดุอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลของข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้กล่าวเป็นเพ็นฐานของเทคโนโลยีการเผาไหม้และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม [19-25]

กระบวนการการเผาไหม้มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง สำหรับวัสดุชั้นสูงและกระบวนการผลิตเพื่อการประยุกต์พลังงาน ในปัจจุบันการควบคุมความเร็วของการจุดระเบิด อุณหภูมิ สัดส่วน และโครงสร้างของผลผลิตทำได้โดยการประยุกต์แนวคิดแผนใหม่ของทฤษฎี การเผาไหม้ และโครงสร้างจนพลาสติร์มหัพภาคของปฏิกิริยาเคมี ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการทั่วไปของการเผาไหม้ได้ดังภาพ 12



ภาพ 12 การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการการเผาไหม้ [16]

ช่วงที่หนึ่ง เป็นช่วงเริ่มต้นของปฏิกิริยา ช่วงที่สอง เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยา ซึ่งช่วงนี้จะยังไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น แต่จะมีการถ่ายเทความร้อนเพิ่มมากขึ้น ช่วงที่สามเป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างของวัสดุ โดยจะมีการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมามেื่อเกิดการจุดระเบิด และความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานี้จะแพร่ไปสู่ช่วงต้นของช่วงที่สี่ คือช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (chemical conversion) ส่วนที่กว้างที่สุดของช่วงนี้คือส่วนที่มีการมีการเปลี่ยนแปลงเฟสและโครงสร้างของวัสดุ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างสุดท้ายและมีบทบาทสำคัญต่อสมบัติของวัสดุ

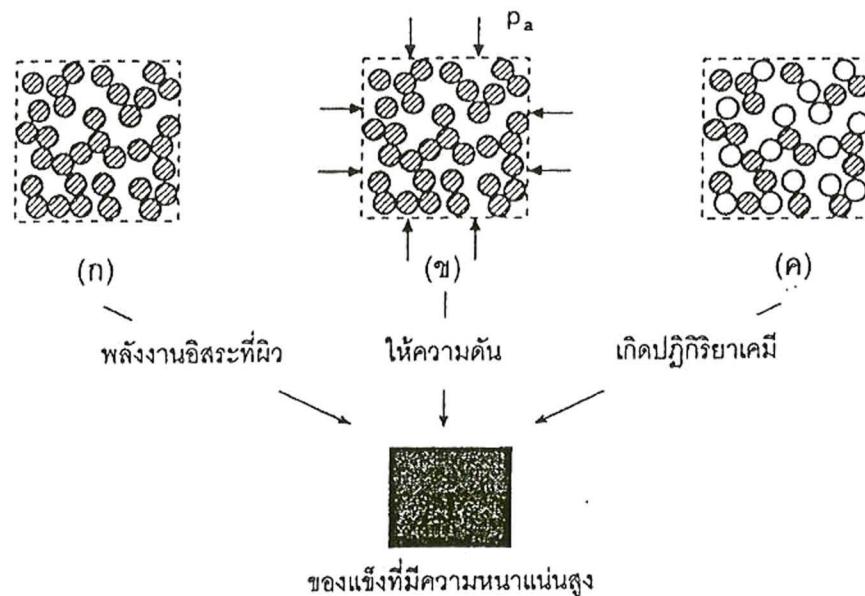
ในช่วงที่ห้าของกระบวนการ เป็นช่วงที่วัสดุเกิดการเย็นตัว และในช่วงนี้อาจมีผลกระบวนการต่อโครงสร้างของวัสดุ ถ้าการเย็นตัวลงเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ จะทำให้โครงสร้างของวัสดุที่สมดุล ดังนั้นในกระบวนการการเผาไหม้ อัตราการให้ความร้อนจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบ

ของการปลดปล่อยความร้อนและถ่ายเทความร้อนไปสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ส่วนคุณลักษณะของวัสดุที่ได้จะขึ้นอยู่กับเพส โครงสร้าง เงื่อนไข และอัตราการเย็นตัวของวัสดุ [16]

การซินเตอร์เซรามิก

การซินเตอร์เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตเซรามิก เซรามิกจะถูกเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้ได้โครงสร้างจุลภาค (microstructure) ตามที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ได้คุณสมบัติต่างๆตามที่ต้องการด้วย

กระบวนการซินเตอร์เกิดขึ้นได้ด้วยพลังงานขับสำหรับการซินเตอร์ (driving forces for sintering) และจะเกิดขึ้นควบคู่กับการลดพลังงานอิสระรวมของระบบ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ความโค้งของผิว ความดันจากภายนอก และปฏิกิริยาเคมี ดังภาพ 13



ภาพ 13 พลังงานขับสำหรับการซินเตอร์ [26]

ความโค้งของผิวจะเป็นพลังงานขับสำหรับการซินเตอร์เมื่อมีความเด่นจากภายนอก และมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น พิจารณาพิริมาณ 1 โมล ที่ประกอบด้วยอนุภาคทรงกลมที่มีรัศมี a และมีจำนวนอนุภาครวมเป็น

$$N = \frac{3M}{4\pi a^3 \rho} \quad (2.15)$$

$$N = \frac{3V_m}{4\pi a^3} \quad (2.16)$$

เมื่อ ρ	คือ ความหนาแน่นของอนุภาค
M	คือ น้ำหนักโมเลกุล
V_m	คือ ปริมาตรโดยโมล
a	คือ รัศมีของอนุภาค

และพื้นที่ผิวของอนุภาคในระบบ คือ

$$S_A = 4\pi a^2 N \quad (2.17)$$

รวมสมการ 2.16 และ 2.17 จะได้

$$S_A = \frac{3V_m}{a} \quad (2.18)$$

กำหนดให้ γ_s เป็นแรงตึงผิวของอนุภาค ดังนั้นพลังงานอิสระที่ผิวของอนุภาค คือ

$$E_s = \gamma_s S_A \quad (2.19)$$

รวมสมการ 2.18 และ 2.19 จะได้

$$E_s = \frac{3\gamma_s V_m}{a}$$

(2.20)

ค่า E_s จะบ่งบอกถึงการลดลงของพลังงานอิสระที่ผิวของระบบ ซึ่งพลังงานที่ผิวนี้เองจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในการซินเตอร์

ถ้าในระบบใด ๆ ไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น ความดันที่ได้จากการบานออกจะเป็นตัวการสำคัญในการให้พลังงานขับในการซินเตอร์ โดยความดันจะให้แก่ระบบขณะที่มีการให้ความร้อนไปด้วย สำหรับอนุภาคผงปริมาณ 1 โมล จะให้งานที่เกิดจากความดันมีค่าประมาณ

$$W = p_a V_m \quad (2.21)$$

เมื่อ p_a	คือ ความดันที่ให้มีหน่วยเป็นเมกะพาสกาล
V_m	คือ ปริมาตรโดยโมล

ในทางปฏิบัติความดันจะมีความสำคัญต่อผลังงานขับในการซินเตอร์มากกว่าความโถงของผิวมากปฏิบัติยาเคมีก็มีผลต่อผลังงานขับในการซินเตอร์ ซึ่งผลังงานจากปฏิบัติยาเคมีนั้นจะมีค่าสูงกว่าผลังงานขับที่เกิดจากความโถงของผิวและความดันจากภายนอกมาก การเปลี่ยนแปลงของผลังงานอิสระที่เกิดขึ้นพร้อมกับปฏิบัติยาเคมี คือ

$$\Delta G^0 = -RT \ln K_{eq} \quad (2.22)$$

เมื่อ ΔG^0 คือ การเปลี่ยนแปลงผลังงานอิสระ

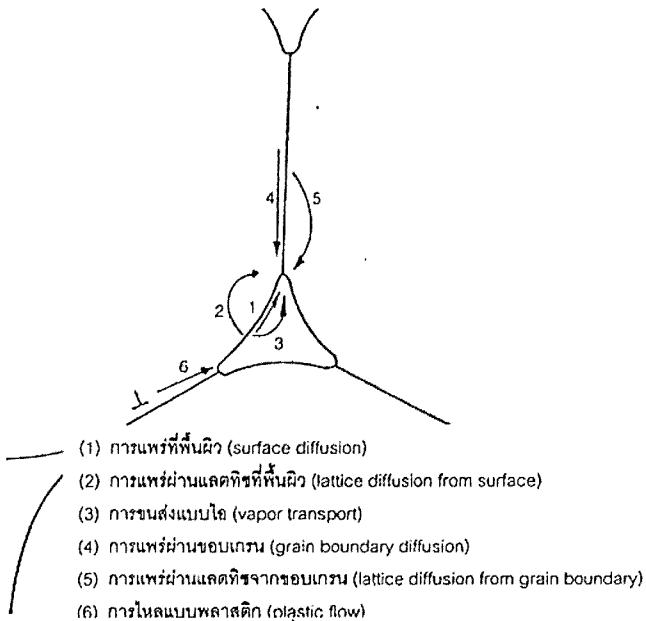
R คือ ค่าคงที่ของแก๊ส ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.3 จูลต่อโมล

T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ มีหน่วยเป็นเคลวิน

K_{eq} คือ ค่าคงที่สมดุลการเกิดปฏิบัติยา

ถึงแม้การเกิดปฏิบัติยาเคมีจะให้ผลังงานขับสูงมาก แต่ค่าผลังงานที่ได้จะไม่ได้ถูกใช้โดยตรงในกระบวนการแน่นตัวของเซรามิกชั้นสูง เนื่องจากการควบคุมโครงสร้างจุลภาคทำได้ค่อนข้างยากเมื่อเกิดปฏิบัติยาเคมีขึ้น ดังนั้นผลังงานขับที่กล่าวมานั้นทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในกระบวนการซินเตอร์ แต่การซินเตอร์จะเกิดขึ้นจริงเมื่อมีการถ่ายโอนมวลสารขึ้น สำหรับของแข็งที่มีโครงสร้างเป็นผลึก การถ่ายโอนมวลสารจะเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการแพร่

การถ่ายโอนมวลสารในวัสดุที่มีโครงสร้างผลึกเชิงช้อนจะเกิดขึ้นในเส้นทางเฉพาะหนึ่ง ๆ และจะเป็นตัวกำหนดกลไกการซินเตอร์ การถ่ายโอนมวลสารนั้นจะเกิดขึ้นจากบริเวณที่มีศักย์ทางเคมีสูง หรือที่เรียกว่า แหล่งเริ่มต้นของมวลสาร ไปสู่บริเวณที่มีศักย์ทางเคมีต่ำ ที่เรียกว่าปลายทางของมวลสาร ซึ่งกลไกการซินเตอร์มีทั้งสิ้น 6 กลไก ดังภาพ 14



ภาพ 14 กลไกที่มีผลต่อการซินเตอร์ของอนุภาคผลึก [26]

โดยกลไกทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดการเติบโตของคราฟว่างอนุภาค ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอนุภาค และทำให้เกิดความแข็งแรงของระบบอนุภาคคง ในกระบวนการการซินเตอร์จะมีเพียงบางกลไกเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการหดตัว (shrink) และการแน่นตัว (density) ของอนุภาค ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 แสดงกลไกการซินเตอร์

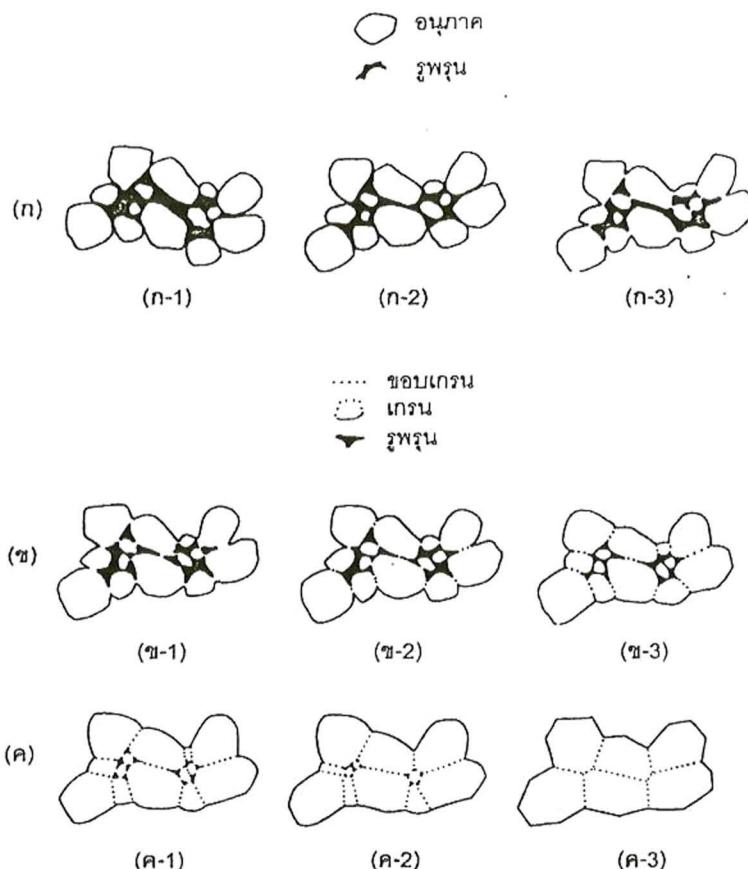
กลไก	แหล่งเริ่มต้น ของมวลสาร	ปลายทาง ของมวลสาร	เกิดการ แน่นตัว	ไม่เกิดการ แน่นตัว
การแพร่ที่พื้นผิว	พื้นผิว	คราฟว่าง		/
การแพร่ผ่านแคดทิล	พื้นผิว	คราฟว่าง		/
การขนส่งแบบไอ	พื้นผิว	คราฟว่าง		/
การแพร่ผ่านขอบเกรน	ขอบเกรน	คราฟว่าง	/	
การแพร่ผ่านแคดทิลจากขอบ เกรน	ขอบเกรน	คราฟว่าง	/	
การไหลแบบพลาสติก	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	/	

การซินเตอร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง โครงสร้างอุลภาคนองผงที่ถูกอัดจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการซินเตอร์ ซึ่งจะผ่านขั้นตอนสำคัญ 3 ช่วง คือ การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (initial stage of sintering) การซินเตอร์ช่วงกลาง (intermediate stage of sintering) และการซินเตอร์ช่วงสุดท้าย (final stage of sintering) การแบ่งช่วงการซินเตอร์จะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอนุภาคที่มาเข้มต่อและการหายไปของรูพรุน

การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้นจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของอนุภาค และการเติบโตของบริเวณระหว่างอนุภาค ที่เรียกว่า คอ อย่างรวดเร็ว ดังภาพ 15 (ก) โดยการเติบโตนี้จะเกิดจาก การแพร่ การขนส่งแบบไอ การไหลแบบพลาสติก สำหรับระบบผงที่ประกอบด้วยอนุภาคทรงกลมจะมีการแผ่นด้วยเกิดขึ้นพร้อมกับการเติบโตของคอ ซึ่งมีผลทำให้ความแตกต่างของความడึงที่ผิวหายไป การซินเตอร์ในช่วงนี้จะเกิดขึ้นจนกระทั่งรัศมีของคอมีค่าประมาณ 0.4-0.5 เท่าของรัศมีอนุภาค และสำหรับระบบผงที่มีความหนาแน่นเบื้องต้นประมาณ 0.5-0.6 เท่าของความหนาแน่นทางทฤษฎี จะมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นประมาณ 0.65 เท่าของความหนาแน่นทางทฤษฎี

การซินเตอร์ช่วงกลางจะเริ่มต้นเมื่อรูพรุนมีรูปร่างสมดุล การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอนุภาคในช่วงกลางนี้แสดงดังภาพ 15 (ข) จะเห็นว่าขนาดคอจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณรูพรุนน้อยลงสัมพันธ์กับการหดตัวของอนุภาค จุดศูนย์กลางของอนุภาคจะเข้ามาใกล้กันมากขึ้น และขอบเกรนเริ่มเคลื่อนทำให้ออนุภาคหนึ่ง ๆ ที่เรียกว่า เกรน เริ่มโตและเกรนที่อยู่ข้างเคียงเริ่มหายไปในเกรนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเรขาคณิตของเกรน คอ และรูพรุน จกกว่ารูพรุนจะมาเข้มต่อ กันและสิ้นสุดเมื่อรูพรุนเริ่มแยกตัวออกจากกัน เป็นรูพรุนเดี่ยว ๆ (isolated pores) ทำให้การซินเตอร์ในช่วงนี้ใช้เวลานานที่สุด และเกิดการหดตัวมากกว่าช่วงอื่น ๆ มีผลทำให้ความหนาแน่นมีค่าประมาณ 0.9 เท่าของความหนาแน่นทางทฤษฎี

ในการซินเตอร์ช่วงสุดท้ายรูพรุนที่อยู่ใกล้กับขอบเกรนจะถูกกำจัดออกจากระบบโดยการแพร่ ซึ่งจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของขอบเกรนและควบคุมการเติบโตของเกรน ถ้าการเติบโตของเกรนเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไป ขอบเกรนจะเคลื่อนที่เร็วกว่ารูพรุน จะส่งผลให้รูพรุนแยกตัวไปอยู่ในเกรน ซึ่งจะกำจัดรูพรุนออกไปได้อย่าง ดังนั้นจะต้องควบคุมการเติบโตของเกรนเป็นอย่างดี เพื่อกำจัดรูพรุนเป็นไปได้มากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอนุภาคในการซินเตอร์ช่วงสุดท้ายนี้แสดงดังภาพ 15 (ค)



ภาพ 15 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะเติบโต [26]

เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกโตมิเตอร์

เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกโตมิเตอร์ (x-ray diffractometer; XRD) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สัดส่วนฐาน เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก (crystal structure) การจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิงปริมาณ (quantitative) โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอกซ์ และความรู้เกี่ยวกับระบบโครงสร้างผลึก (crystallography) เครื่องมือชนิดนี้มีความสำคัญมากในการบันการควบคุมคุณภาพการผลิตสำหรับตรวจสอบสมบัติของวัสดุต่างๆ และผลิตภัณฑ์ในการบันการผลิตขั้นตอนต่อไป

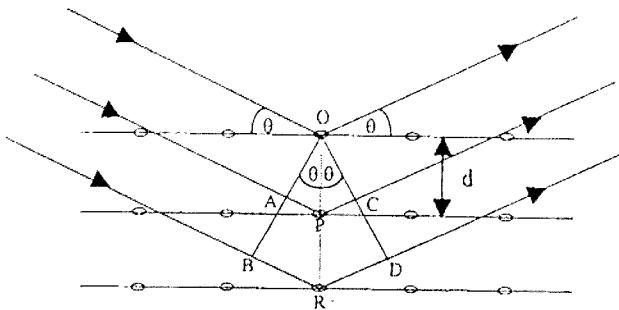
รังสีเอกซ์ (x-ray) จัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอำนาจทางลุทธะลวงสูง มีความยาวคลื่นสั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.01-10 นาโนเมตร อันตรกิริยาของรังสีเอกซ์กับสารนั้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น เกิดการเปล่งแสง (emission) การดูดกลืน (absorption) การกระเจิง

(scattering) การเลี้ยวเบน (diffraction) เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิดซึ่งหลักการดังกล่าวเนี่ยเรายังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สารได้ดังนี้

1. วิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตุต่างๆ ในสารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี
3. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก หรือโมเลกุลของสารด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบน

รังสีเอกซ์

การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จะเกิดเมื่อลำรังสีเอกซ์ตกกระทบผิวหน้าของผลึกโดยทำมุม θ บางส่วนของรังสีเอกซ์จะเกิดการสะท้อนด้วยชั้นของอะตอมที่ผิวหน้า อีกส่วนของรังสีเอกซ์จะผ่านไปยังชั้นที่ 2 ของอะตอม ซึ่งบางส่วนจะเกิดการสะท้อน และส่วนที่เหลือจะผ่านเข้าไปยังชั้นที่ 3 ของอะตอมดังแสดงในภาพ 16



ภาพ 16 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์

ถ้าอะตอมในผลึกมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและมีระยะห่างระหว่างอะตอมเท่าๆ กัน สำหรับรังสีเอกซ์ที่ผ่านเข้าไปแต่ละชั้นของอะตอมจะเกิดการเลี้ยวเบนเป็นลำชานกัน ซึ่งการเกิดเลี้ยวเบนนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ

1. รังสีตัดกระทบ รังสีเลี้ยวเบน และเส้นตั้งฉากกับผิวหน้าจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
2. ระยะห่างระหว่างชั้นของอะตอมควรมีค่าใกล้เคียงกับความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์

ในปี ค.ศ. 1912 แบรగ (W.L. Bragg) "ได้ยิงลำรังสีเอกซ์แคบ ๆ กระทบผิวหน้าผลึกเป็น มุม θ เพื่อให้เกิดการเลี้ยวเบนและเกิดการสะท้อน เมื่อเกิดอันตรกิริยา กับอะตอม O, P และ R ผลึกจะทำหน้าที่สะท้อนรังสีเอกซ์ดังภาพ 16 และถ้า

$$AP + PC = n\lambda \quad (2.23)$$

เมื่อ n คือ ตัวเลขจำนวนเต็ม

และ

$$AP = PC = d \sin \theta \quad (2.24)$$

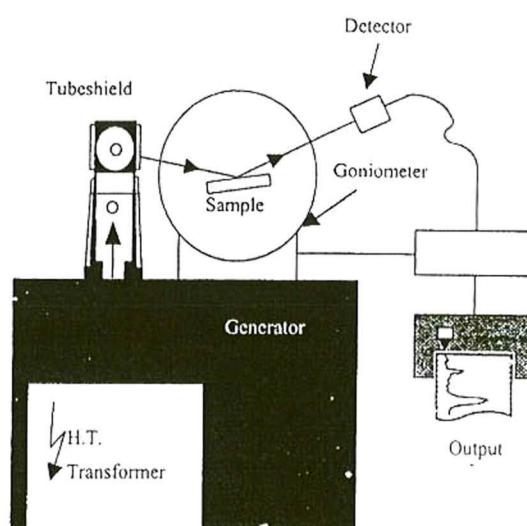
เมื่อ d คือ ระยะห่างระหว่างชั้นของผลึก

ถ้าคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบเสริมและเมื่อร่วมสมการ 2.23 และ 2.24 เข้าด้วยกัน อาจเขียนสมการใหม่ได้เป็น

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (2.25)$$

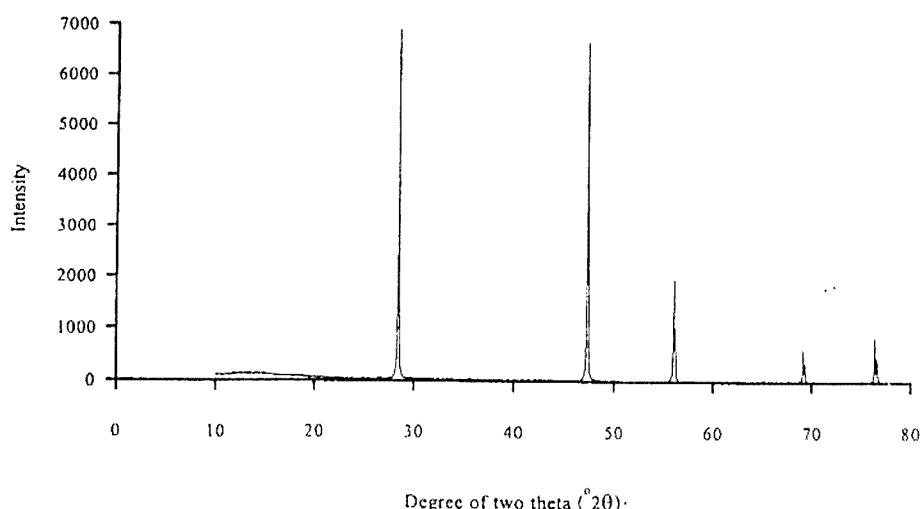
เรียกสมการนี้ว่า สมการของแบรกค์ (Bragg's equation) แบรกค์ได้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษาผลึกไว้ว่า ผลึกประกอบด้วยโครงตาก្រายที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมในลักษณะที่เป็นกลุ่มของระนาบที่ขนานกัน เมื่อรังสีของคลื่นตักกระแทบกลุ่มของระนาบที่ขนานกันภายใต้ผลึก แต่ละระนาบจะสะท้อนรังสีตักกระแทบบางส่วนออกมาในลักษณะคล้ายกับกระเจา แนวรังสีสะท้อนจะพบได้เมื่อรังสีสะท้อนจากกลุ่มระนาบที่ขนานกันเกิดการแทรกสอดแบบเสริม และพลังงานรังสีเอกซ์ที่สะท้อนออกมาจะมีค่าเท่ากับพลังงานรังสีเอกซ์ที่ตกกระแทบ

จากแนวความคิดข้างต้น จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟρกชันขึ้น ซึ่งมีหลักการทำงานแสดงดังภาพ 17



ภาพ 17 หลักการทำงานของเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟρกชัน [27]

การทำงานของเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชันเริ่มจากหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแรงสูง (high tension transformer) ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขั้วแคโทดทำให้ค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วแคโทดและแอนโโนดเพิ่มสูงขึ้น อิเล็กตรอนวิ่งเข้าชนเป้าที่ขั้วแอนโโนดและเกิดการปลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมานอกมา หลอดรังสีเอกซ์มีหอยาชนิดชิ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่ใช้ทำขั้วแอนโโนด เช่น Mo, W, Cr, Cu Co, Ag, Fe ซึ่งให้รังสีเอกซ์ที่มีค่าความยาวคลื่นต่างๆ กัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสารที่ต้องวิเคราะห์ แต่โดยทั่วไปนิยมใช้ Cu มีค่าความยาวคลื่นเท่ากับ 1.542 อังสตรอม ซึ่งจะให้รังสีเอกซ์ทั้ง K_{α} และ K_{β} แต่ในการวิเคราะห์จำเป็นต้องใช้รังสีเอกซ์ความยาวคลื่นเดียวก็ต้องมีการกรองให้เหลือเพียง K_{α} จากนั้นรังสีเอกซ์จะถูกบีบให้เป็นลำแสงโดยไดเวอร์เจนสลิต (divergence slit) สำหรับรังสีเอกซ์ที่ผ่านไดเวอร์เจนสลิตจะตกลงบนตัวอย่างซึ่งติดไว้ กับแกนของ โภโนໂມเตอร์ (goniometer) รังสีที่สะท้อนจากตัวอย่างจะผ่านไปยังรีซีฟิงสลิต (receiving slit) และเข้าไปยังหน่วยรับสัญญาณเพื่อแปลงสัญญาณออกมานิรูปดิฟแฟร์กโตแกรม (diffractogram) แสดงความสมพันธ์ระหว่างมุม 2θ และค่าความเข้มของรังสี แสดงดังภาพ 18



ภาพ 18 ดิฟแฟร์กโตแกรมของแผ่นซิลิกอน [28]

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope) เป็นการประยุกต์โดยการนำเอาอิเล็กตรอนที่มีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นแสงมาใช้แทนคลื่นแสงและใช้เลนส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแทน

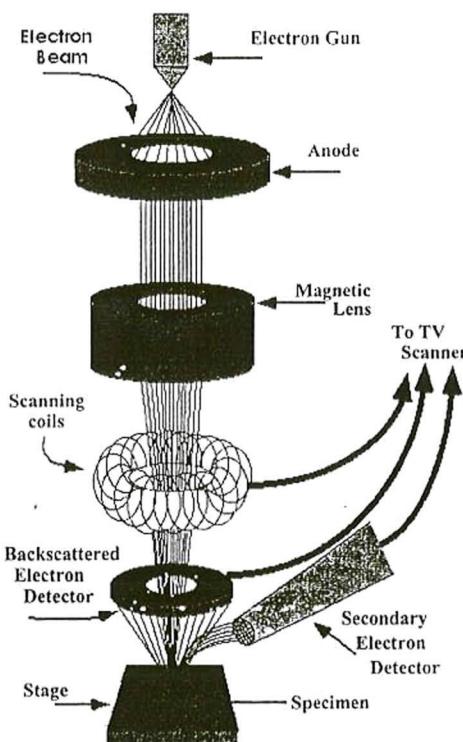
เลนส์กระเจก และมีตัวตรวจวัดสำหรับจับสัญญาณอิเล็กตรอนที่เกิดจากลำอิเล็กตรอนไปกระทบผิวด้วยกัน จากนั้นจะมีอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณที่ได้ให้เป็นสัญญาณภาพ ทำให้ได้ภาพของตัวอย่างที่มีกำลังขยายมากกว่า 3,000 เท่า ถึงระดับมากกว่า 100,000 เท่า

ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope; SEM) หลักการเกิดภาพเริ่มจากการที่อิเล็กตรอนปฐมภูมิ (primary electron) จากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน (electron gun) ถูกเร่งด้วยศักย์ไฟฟ้าสูง จากนั้นจะถูกดึงดูดลงสู่เบื้องล่างด้วยเอนด์แอลโนด ภายใต้ความดันสูงมาก แล้วเพิ่มความเข้มของลำอิเล็กตรอนด้วยชุดคอนเดนเซอร์เลนส์ โดยการปรับให้ล้ำของอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กลง จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะวิ่งลงสู่เบื้องล่างผ่านเลนส์สวัตตุ ซึ่งทำหน้าที่ปรับลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิให้มีจุดโฟกัสบนผิวด้วยกันอยู่ด้วยชุดขดลวดควบคุมการส่องกราด (scanning coil) ทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอนบนผิวด้วยกัน แสดงดังภาพ 19 ขณะที่อิเล็กตรอนกระทบผิวด้วยกันจะเกิดอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมของสารตัวอย่าง และเกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ชั้นความลึกจากพื้นผิวที่ระดับต่าง ๆ ทำให้เกิดการปลดปล่อยสัญญาณอิเล็กตรอน (electron signal) ชนิดต่าง ๆ ออกมายานั้นตัวแปลงสัญญาณเกิดเป็นภาพประกายบนจอรับภาพ ซึ่งสัญญาณอิเล็กตรอนชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่

1. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron image) เป็นกลุ่มอิเล็กตรอนพลังงานต่ำอยู่ในช่วง 3 ถึง 5 อิเล็กตรอนโวลต์ เกิดที่พื้นผิวด้วยความลึกไม่เกิน 10 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจาชาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนที่ผิวด้วยกัน

2. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระแสเจิงกลับ (backscattered electron image) เป็นกลุ่มอิเล็กตรอนที่สัญเสียงพลังงานให้กับอะตอมในชั้นงานเพียงบางส่วนและกระแสเจิงกลับออกมากซึ่งมีพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนทุติยภูมิ เกิดที่ระดับความลึกมากกว่า 10 นาโนเมตร

3. สัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ (x-ray image) เกิดจากการที่อิเล็กตรอนในระดับชั้นโคจรต่าง ๆ ได้รับพลังงานมากพอจนหลุดจากวงโคจร เมื่ออิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นถัดไปซึ่งมีระดับพลังงานสูงกว่าเข้ามาแทนที่ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมายังรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นที่ระดับความลึก 0.2-2 ไมโครเมตร



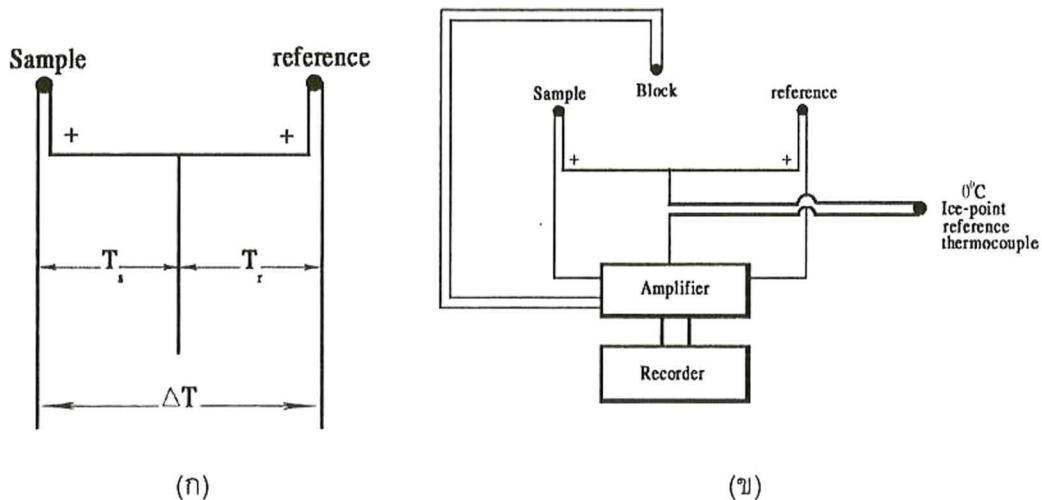
ภาพ 19 ส่วนประกอบและหลักการทำงานเบื้องต้นของ SEM [28]

เครื่อง differential thermal analysis (DTA)

การวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วยเครื่อง differential thermal analysis (DTA) ทำได้ด้วย การวัดอุณหภูมิที่ต่างกันระหว่างสารตัวอย่างกับสารอ้างอิง ในระหว่างที่ให้ ความร้อนอุณหภูมิของสารตัวอย่างจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะการดูด (endothermic) หรือการ ดายความร้อน (exothermic) อันเนื่องมาจากเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานภายใน เช่น การเปลี่ยนเฟส การละลาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก การเดือด การเผาไหม้ การระเหย การขยายตัว การแตกตัว กระบวนการออกซิเดชัน (oxidation) ริดักชัน (reduction) และปฏิกิริยา เคมีต่างๆ

โดยทั่วไปการวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วยเครื่อง DTA ต้องทำภายใต้ห้องควบคุม บรรยายกาศซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ (thermocouple) ถ่วงใส่สารตัวอย่าง และสาร อ้างอิง ซึ่งทำจากวัสดุที่มีสมบัติเรื่อยต่อการเปลี่ยนแปลงในช่วงอุณหภูมิที่ทดลอง และมีค่า thermal conductivity สูงเพื่อให้สามารถนำความร้อนสู่ตัวอย่างและสารอ้างอิงได้ดี และเมื่อให้ ความร้อนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะถูกตรวจวัดค่าความแตกต่างอุณหภูมิของสารตัวอย่าง

(T_s) และสารอ้างอิง (T_r) แสดงดังภาพ 20 จากนั้นค่าความต่างของอุณหภูมิจะถูกบันทึกเป็นกราฟ

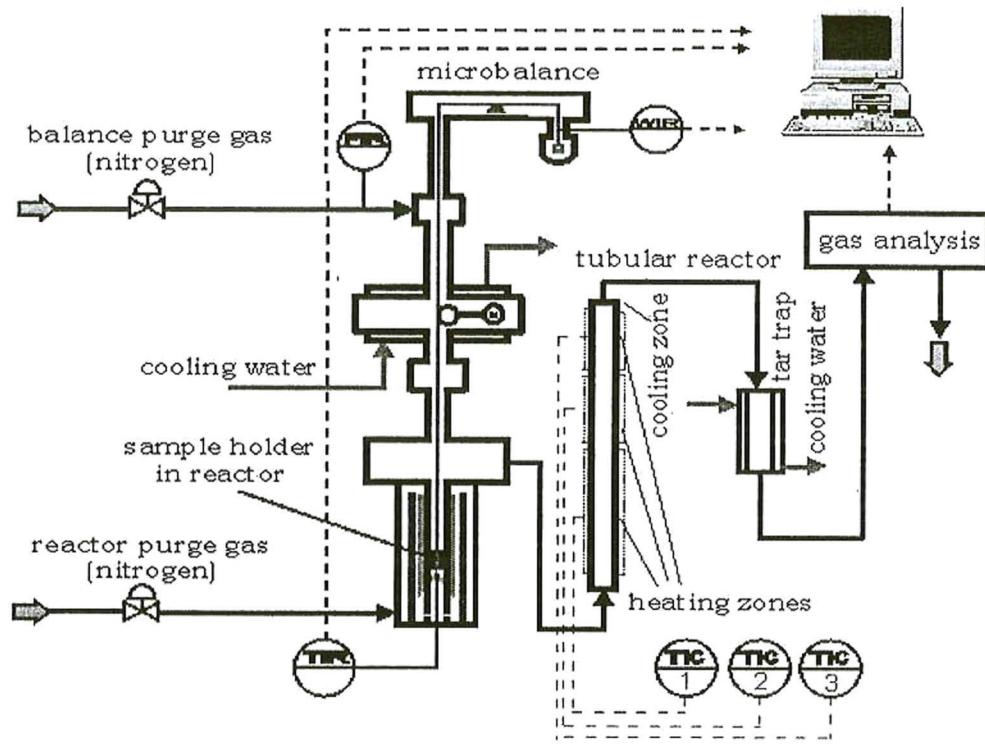


ภาพ 20 (ก) ส่วนประกอบของ DTA (ข) หลักการทำงานของเครื่อง DTA [29]

ในการวิเคราะห์อัตราการการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองมักอยู่ในช่วง 2-20°C/นาที การเลือกใช้สารอ้างอิงควรเลือกให้มีสมบัติทางด้านความร้อนใกล้เคียงกับสารตัวอย่าง และควรเป็นสารที่เรียบในทุกช่วงอุณหภูมิของการทดลอง อลูมีนา (alumina) เป็นวัสดุที่นิยมใช้เป็นสารอ้างอิง ในกรณีที่สารตัวอย่างเป็นของเหลวต้องใช้สารอ้างอิงที่เป็นของเหลว เช่น พาราฟินเหลว (liquid paraffin) [30]

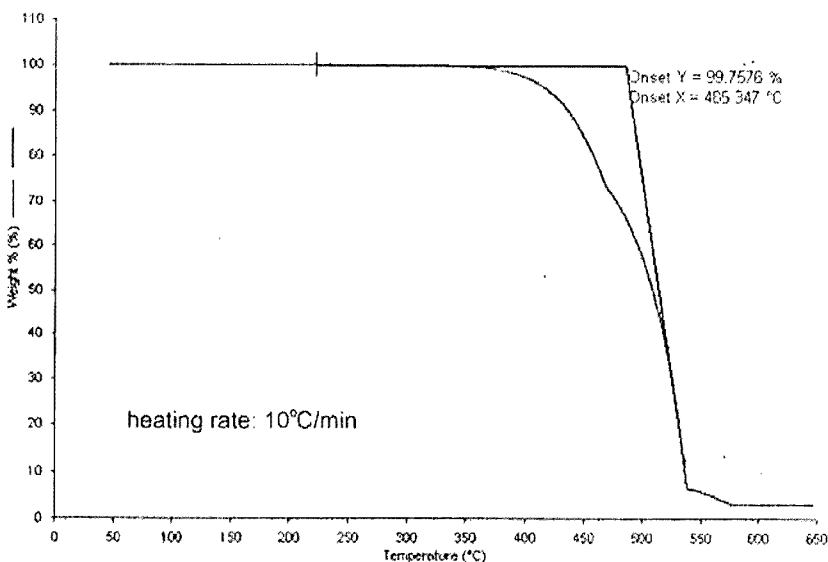
เครื่อง thermal gravimetric analysis (TGA)

TGA เป็นเทคนิควิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยการวัดการสูญเสียน้ำหนัก (weight loss) ของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เมื่อวัสดุได้รับความร้อนก็จะเกิดการสูญเสียน้ำหนักอันเนื่องมาจากกระบวนการระเหยของน้ำ หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดแก๊ส



ภาพ 21 ส่วนประกอบของเครื่อง TGA [31]

การทำงานของ TGA จะต้องทำการวัดในระบบปิดซึ่งประกอบด้วย sample holder ที่มีโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิ บรรยายกาศ ความดัน และเชื่อมตอกับระบบชั่งน้ำหนัก แสดงดังภาพ 21 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายใน sample holder และทำให้เกิดการสูญเสีย น้ำหนักของสารตัวอย่าง micro balance จะส่งสัญญาณน้ำหนักไปเก็บที่คอมพิวเตอร์จากนั้นจะ แปลงให้เป็นค่า percent weight และได้กราฟการเปลี่ยนแปลง percent weight กับอุณหภูมิ [32] แสดงดังภาพ 22



ภาพ 22 แสดงผลวิเคราะห์ TGA [33]

การหาค่าความหนาแน่น

ความหนาแน่น (density) หมายถึง ค่ามวลต่อปริมาตรของวัสดุ ณ อุณหภูมิหนึ่ง ๆ จัดเป็นสมบัติทางกายภาพอย่างหนึ่งของวัสดุ และมีประโยชน์อย่างยิ่งกับงานทางด้านเซรามิก ซึ่งอาศัยค่าความหนาแน่นเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการอัดแน่นตัวของวัสดุในระหว่างขั้นตอนการขึ้นรูป

การหาค่าความหนาแน่นอาศัยหลักการของかる์คิมีดีสที่กล่าวไว้ว่า "เมื่อจุ่มของแข็งลงในของเหลวจะมีแรงพยุงเกิดขึ้นบนของแข็งนั้น โดยแรงพยุงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยปริมาตรของแข็ง" ซึ่งการหาค่าความหนาแน่นทำได้โดยการหาค่ามวลของวัตถุในอากาศและขณะที่จุ่มอยู่ในน้ำ และสามารถคำนวณค่าความหนาแน่น (ρ) ได้จากสมการ

$$\rho = \frac{W_a}{W_a - W_{fl}} \cdot \rho_{fl} \quad (2.26)$$

เมื่อ ρ	คือ ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน (g/cm^3)
ρ_{fl}	คือ ค่าความหนาแน่นของของเหลว (g/cm^3)
W_a	คือ น้ำหนักแห้งของชิ้นงาน (g)
W_{fl}	คือ น้ำหนักของชิ้นงานในของเหลว (g)

อุปกรณ์ในการหาค่าความหนาแน่นของวัสดุประกอบด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้าที่สามารถอ่านค่าทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง และอุปกรณ์ประกอบซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย

1. บีกเกอร์
2. บาร์เพรม
3. แผ่นโลหะรองรับบีกเกอร์
4. ตะแกรงสำหรับรองรับชิ้นงานขณะชั่งงานอยู่ในของเหลว [28]

ค่าความหนดตัว

ค่าความหนดตัวในแนวเชิงเส้นตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานหลังจากการเผาซินเตอร์ หาได้โดยใช้สมการ 2.27 [34]

$$A = \frac{\phi_i - \phi_f}{\phi_i} \times 100\% \quad (2.27)$$

เมื่อ	A	คือ ค่าความหนดตัวตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง
	ϕ_i	คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยก่อนเผาซินเตอร์
	ϕ_f	คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยหลังเผาซินเตอร์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้ศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเตรียมผงและเซรามิกแบบเรียมเซอร์โคเนตไทยาเนต ด้วยวิธีปั๊วกริยาสถานะของแข็ง และวิธีการเผาใหม่ในการลดอุณหภูมิในการเผาเคลื่อนและซินเตอร์ลง และศึกษาสมบัติทางกายภาพของผงและเซรามิกแบบเรียมเซอร์โคเนตไทยาเนตโดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

Zhi Yu และคณะ [17] ได้ศึกษาพฤติกรรมเฟอร์โรอิเล็กทริกและเซอร์โคเนตไทยาเนตในช่วงอุณหภูมิ 150 K ถึง 450 K พบร่วมกับอุณหภูมิ 175 K จะทำให้ได้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกและสมบัติโพลาไรเซชันที่สูง ซึ่งหมายความว่าการประยุกต์ใช้ที่อุณหภูมิต่ำ

Zhi Yu และคณะ [3] ได้ทำงานวิจัยเรื่อง Dielectric properties and tunability of ceramics Ba_{(Ti_{0.7}Zr_{0.3})O₃} under dc electric field. ได้ทำการศึกษาสมบัติของแบบเรียมเซอร์โค-

เนตที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง โดยทำการวัดค่าคงตัวไดอิเล็กทริก ค่าสูญเสียไดอิเล็กทริกภายใต้สนามไฟฟ้า พบว่าที่สนามไฟฟ้ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 kV/cm ที่อุณหภูมิ 300 K ทำให้ได้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่สูงและมีค่าสูญเสียต่ำ (~ 0.002) และได้ค่าทันตะบลิต์สูงประมาณ 45%

X.G.Tang และคณะ [4] ได้ศึกษาสมบัติของแบเรย์มเซอร์โคเนตไททาเนต (BZT, $x=0.20, 0.25, 0.30, 0.35$) ที่เตรียมด้วยวิธี โซล-เจล พบว่า ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกมีค่าขึ้นกับอุณหภูมิ และเมื่อองค์ประกอบของเซอร์โคเนียม (Zr) เพิ่มสูงขึ้นก็จะยิ่งทำให้ diffuse phase transition มากขึ้นด้วย และเมื่อ $x > 0.25$ จะทำให้ได้ค่าทันตะบลิต์ (k) และ figure of merit (FOM) ที่สูงเหมาะสำหรับการประยุกต์ทางด้าน tunable capacitor

Rui-hong Liang และคณะ [5] ได้ศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริก และทันตะบลิต์ของแบเรย์มเซอร์โคเนตไททาเนต (BZT, $x= 0.25, 0.30, 0.35, 0.40$) ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง พบรากการแทนที่ไททาเนียม (Ti) ด้วยเซอร์โคเนียม (Zr) มีผลต่อคุณสมบัติไดอิเล็กทริกและขนาดของเกรน และเมื่อ $x=0.25, 0.30, 0.35$ ภายในไดส์นามไฟฟ้า 2 kV/mm จะทำให้ได้ค่าทันตะบลิต์สูง ($27.6\%, 26.3\%, 19.7\%$ ตามลำดับ) และที่อุณหภูมิห้องความถี่ 10 kHz จะมีค่าสูญเสียไดอิเล็กทริกที่ต่ำ ($0.001-0.002, 0.001-0.002, 0.004-0.005$) ซึ่งเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไมโครเวฟ

Dongfeng Xue และคณะ [6] ได้ศึกษาระบวนการปฏิกิริยาสถานะของแข็งที่อุณหภูมิต่ำของโซเดียมแทนทาเลต (NaTaO_3) โดยใช้ยูเรียนสัดส่วน $2:1$ พบรากสามารถลดอุณหภูมิในการเผาจาก $1,000-1,300^\circ\text{C}$ เหลือเพียง 600°C